

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



600W 半導体レーザースタック

製品シリーズ



出力

600W

出力／バー

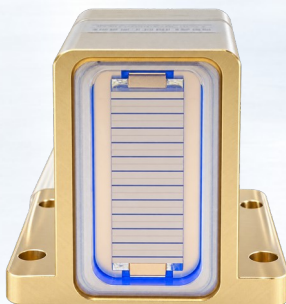
50W / 100W

波長オプション

**755 / 780 / 808 /
1064 nm**

チップオプション

**米国 Coherent /
中国製**



業務用美容レーザー機器向け

HANGZHOU SG

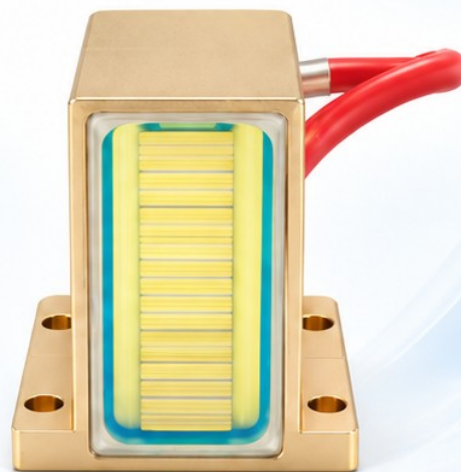
半導体レーザースタック



600W

レーザーモジュール

755 / 780 / 808 / 1064 nm



使用イメージ

**業務用美容レーザー
機器向け**

600W

製品一覧

製品	型式	波長構成	波長	バー数	出力／バー	チップ
	DVS-MS-1006BAI	単一波長	808 nm	6 本	100 W	米国 Coherent
	LST-MS-1006BAI	単一波長	808 nm	6 本	100 W	中国製
	DVS-L-F1006BAI	単一波長	808 nm	6 本	100 W	米国 Coherent (FAC 付き)
	DVS-1006BAI	単一波長	808 nm	6 本	100 W	米国 Coherent
	LSR-3444AS	3 波長	1064 nm*4 755 nm*4 808 nm*4	12 本	50 W	米国 Coherent
	DVS-1012HAI	単一波長	808 nm	6 本	100 W	米国 Coherent
	LST-1012AI	単一波長	808 nm	12 本	50 W	中国製

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



DVS/LST 600W



SG L1051
DVS-MS-1006BAI BY287



SG A2212
LST-MS-1006BAI.U8126

DVS-MS-1006BAI

単一波長

808 nm

LST-MS-1006BAI

単一波長

808 nm

波長

808 nm

スタック

6本 *
100 W

チップ

米国 Coherent

波長

808 nm

スタック

6本 *
100 W

チップ

中国製

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



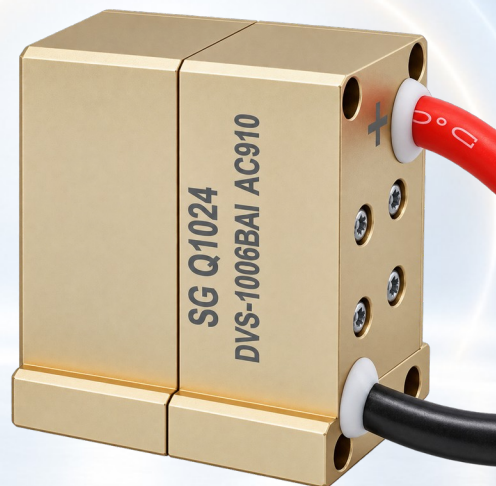
DVS 600W



DVS-L-F1006BAI

単一波長

808 nm



DVS-1006BAI

単一波長

808 nm

波長

808 nm

スタック

6 本 *
100 W

チップ

米国 Coherent
(FAC 付き)

波長

808 nm

スタック

6 本 *
100W

チップ

米国 Coherent

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



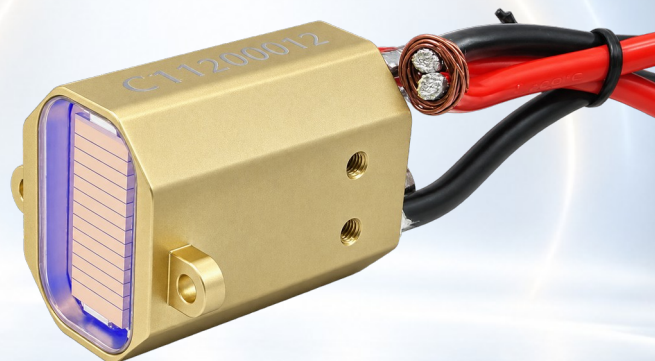
LSR/DVS 600W



LSR-3444AS

3 波長

1064 + 755 + 808 nm



DVS-1012HAI

単一波長

808 nm

波長

1064 nm * 4
755 nm * 4
808 nm * 4

スタック

12 本 *
50 W

チップ

米国 Coherent

波長

808 nm

スタック

6 本 *
100 W

チップ

米国 Coherent

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



LST 600W



LST-1012AI

単一波長

808 nm

波長

808 nm

スタック

12 本 *50 W

チップ

中国製

600W

製品一覧

製品	型式	波長構成	波長	バー数	出力／バー	チップ
	LAS-1012AI	単一波長	808 nm	12 本	50 W	中国製
	LST-3123BAS	3 波長	1064 nm*1 780 nm*2 808 nm*3	6 本	100 W	中国製
	LST-1006BAI	単一波長	808 nm	6 本	100 W	中国製
	LST-1012AI	単一波長	808 nm	12 本	50 W	中国製
	LST-311A AS	3 波長	1064 nm*1 780 nm*1 808 nm*10	12 本	50 W	中国製
	LST-3255AS	3 波長	1064 nm*2 780 nm*5 808 nm*5	12 本	50 W	中国製
	HPL	2 波長	755 nm*6 808 nm*6	12 本	50 W	米国 Coherent
	HPL/LT	3 波長	1064 nm*1 755 nm*5 808 nm*6	12 本	50 W	米国 Coherent

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



LAS/LST 600W



LAS-1012AI

単一波長

808 nm



LST-3123BAS

3 波長

1064 + 780 + 808 nm

波長

808 nm

スタック

12 本 *
50 W

チップ

中国製

波長

1064 nm * 1
780 nm * 2
808 nm * 3

スタック

6 本 *
100 W

チップ

中国製

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



LST 600W



LST-1006BAI

単一波長

808 nm



LST-1012AI

単一波長

808 nm

波長

808 nm

スタック

6 本 *
100 W

チップ

中国製

波長

808 nm

スタック

12 本 *
50 W

チップ

中国製

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



LST 600W



LST-311A AS

3 波長

1064 + 780 + 808 nm



LST-3255AS

3 波長

1064 + 780 + 808 nm

波長

1064 nm * 1
780 nm * 1
808 nm * 10

スタック

12 本 *
50 W

チップ

中国製

波長

1064 nm * 2
780 nm * 5
808 nm * 5

スタック

12 本 *
50 W

チップ

中国製

HPL/LT 600W



HPL
2 波長

755 + 808 nm



HPL/LT
3 波長

1064 + 755 + 808 nm

波長

755 nm * 6
808 nm * 6

スタック

12 本 *
50 W

チップ

米国 Coherent

波長

1064 nm * 1
755 nm * 5
808 nm * 6

スタック

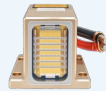
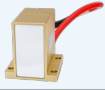
12 本 *
50 W

チップ

米国 Coherent

600W

製品一覧

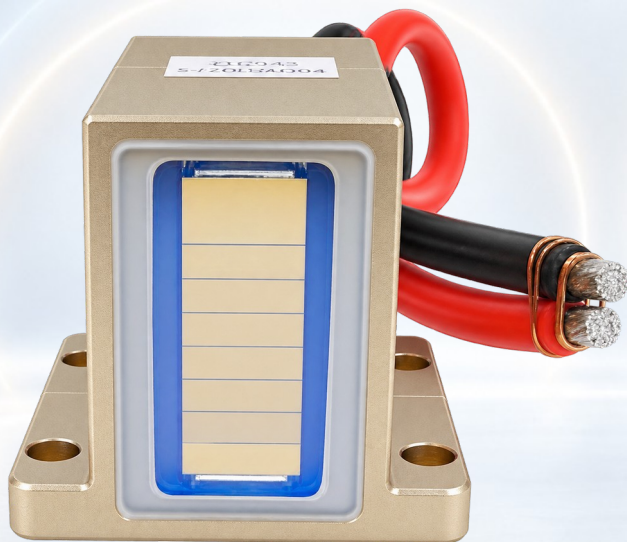
製品	型式	波長構成	波長	バー数	出力／バー	チップ
	HPL	単一波長	808 nm*6	6 本	100 W	米国 Coherent
	HPL/LT	単一波長	808 nm*6	6 本	100 W	米国 Coherent (FAC 付き)
	HPL	単一波長	808 nm*12	12 本	50 W	米国 Coherent
	HPL/LT	3 波長	1064 nm*4 755 nm*4 808 nm*4	12 本	50 W	米国 Coherent
	HD	3 波長	1064 nm*1 780 nm*5 808 nm*6	12 本	50 W	中国製
	HD	3 波長	1064 nm*1 780 nm*1 808 nm*10	12 本	50 W	中国製 (FAC 付き)
	HT/HR	単一波長	808 nm*6	6 本	100 W	中国製
	HT/HR	単一波長	808 nm*12	12 本	50 W	中国製
	HT/HR	3 波長	1064 nm*4 755 nm*4 808 nm*4	12 本	50 W	米国 Coherent
	HT/HR	2 波長	1064 nm*4 808 nm*8	12 本	50 W	中国製

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック

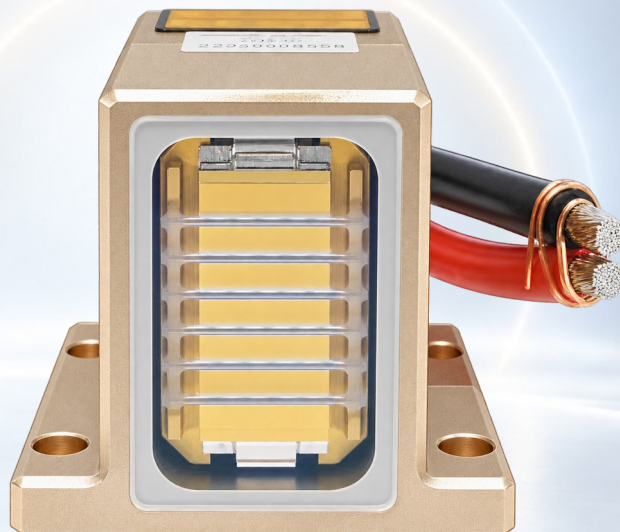


HPL/LT 600W



HPL
単一波長

808 nm



HPL/LT
単一波長

808 nm

波長

808 nm * 6

スタック

6 本 *
100 W

チップ

米国 Coherent

波長

808 nm * 6

スタック

6 本 *
100 W

チップ

米国 Coherent
(FAC 付き)

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



HPL/LT 600W



HPL
単一波長

808 nm



HPL/LT
3 波長

1064 + 755 + 808 nm

波長

スタック

チップ

808 nm * 12

12 本 *
50 W

米国 Coherent

波長

スタック

チップ

1064 nm * 4
755 nm * 4
808 nm * 4

12 本 *
50 W

米国 Coherent

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック

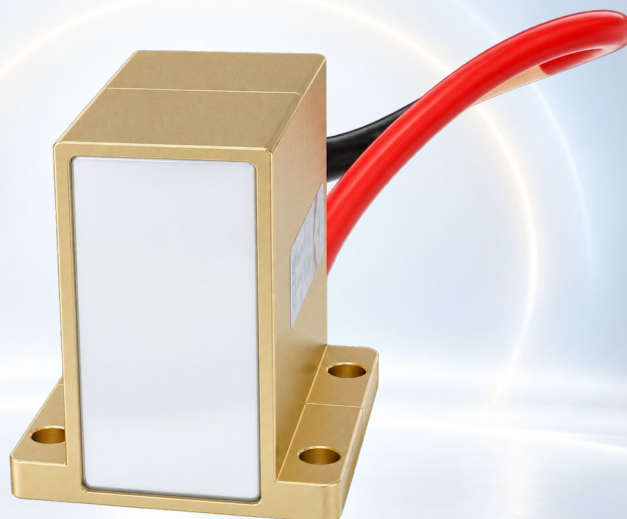


HD 600W



HD
3 波長

1064 + 780 + 808 nm



HD
3 波長

1064 + 780 + 808 nm

波長	スタック	チップ
1064 nm * 1 780 nm * 5 808 nm * 6	12 本 * 50 W	中国製

波長	スタック	チップ
1064 nm * 1 780 nm * 1 808 nm * 10	12 本 * 50 W	中国製 (FAC 付き)

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



HT/HR 600W



HT/HR
単一波長

808 nm



HT/HR
単一波長

808 nm

波長

808 nm * 6

スタック

6 本 *
100 W

チップ

中国製

波長

808 nm * 12

スタック

12 本 *
50 W

チップ

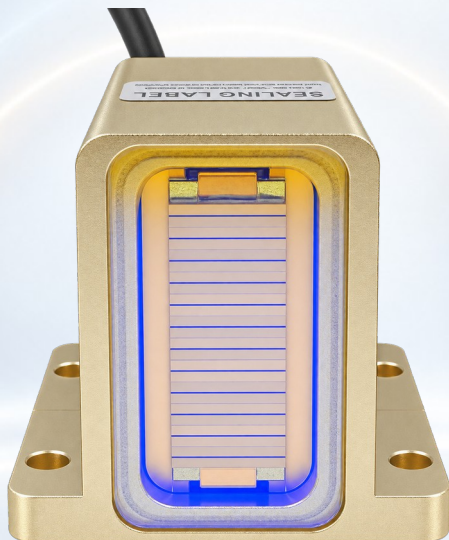
中国製

HANGZHOU SG

半導体レーザースタック



HT/HR 600W



HT/HR

3 波長

1064 + 755 + 808 nm



HT/HR

2 波長

1064 + 808 nm

波長

1064 nm * 4
755 * 4
808 nm * 4

スタック

12 本 *
50 W

チップ

米国 Coherent

波長

1064 nm * 4
808 nm * 8

スタック

12 本 *
50 W

チップ

中国製